

シリコン パワー トランジスタ
Silicon Power Transistor
2SC3660A

NPNエビタキシャル形シリコントランジスタ

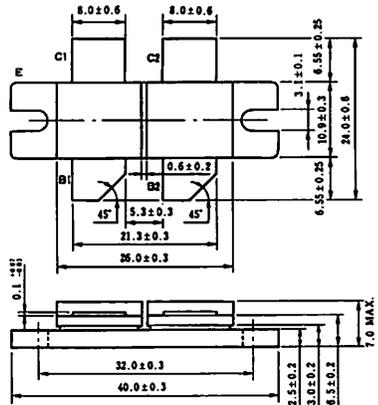
860 MHz帯電力増幅用

通信工業用

特長

- 860 MHz帯において高出力・高効率が得られます。
 $P_o=9\text{ W}$, $\eta_c=50\%$ (TYP.)
 $(V_{CC}=28\text{ V}, f=860\text{ MHz}, I_q=400\text{ mA}\times 2, P_{in}=25\text{ W})$
- エミッタ安定化抵抗を採用。
- 内部整合回路内蔵。
- 金電極のため高い信頼度が得られます。

外形図 (Unit: mm)



絶対最大定格 ($T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$)

| 項目 | 略号 | 定格 | 単位 |
|--------------|---------------------------------------|------------|--------------------|
| コレクタ・ベース間電圧 | V_{CBO} | 55 | V |
| コレクタ・エミッタ間電圧 | V_{CEO} | 32 | V |
| エミッタ・ベース間電圧 | V_{EBO} | 3 | V |
| コレクタ電流 | I_C | 24 | A |
| 熱抵抗 | $R_{th(j-c)}$ * | 0.55 | $^\circ\text{C/W}$ |
| 全損失 | $P_{T(T_a=25\text{ }^\circ\text{C})}$ | 320 | W |
| ジャンクション温度 | T_j | 200 | $^\circ\text{C}$ |
| 保存温度 | T_{stg} | -65 ~ +150 | $^\circ\text{C}$ |

* dV_{BE} 法 ハルス幅50 msとする。

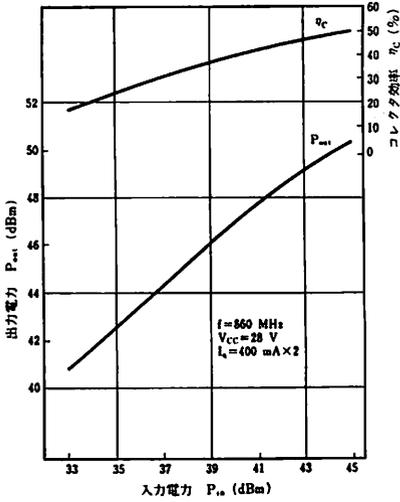
1. ベース1
 2. ベース2
 3. コレクタ2
 4. コレクタ1
 5. エミッタ
- フランジはエミッタと接続されております。

電気的特性 ($T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$)

| 項目 | 略号 | 条件 | MIN. | TYP. | MAX. | 単位 |
|-----------|-------------|---|------|------|------|-----|
| コレクタシャ断電流 | I_{CBO} | $V_{CB}=30\text{ V}, I_E=0$ | | | 8 | mA |
| エミッタシャ断電流 | I_{EBO} | $V_{EB}=2\text{ V}, I_C=0$ | | | 8 | mA |
| 直流電流増幅率 | h_{FE} | $V_{CE}=10\text{ V}, I_C=2\text{ A}$ (ハルス) | 30 | 60 | 100 | |
| コレクタ容量 | C_{ob} ** | $V_{CB}=28\text{ V}, f=1\text{ MHz}, I_E=0$ | | 120 | 200 | pF |
| 出力電力 | P_{out} | $V_{CC}=28\text{ V}, I_q=400\text{ mA}\times 2$ $f=860\text{ MHz},$ $P_{in}=44\text{ dBm}(25\text{ W})$ | 49 | 49.6 | | dBm |
| | | | 79 | 91 | | W |
| コレクタ効率 | η_c | | 40 | 50 | | % |

**エミッタとケースは接地する

OUTPUT POWER AND COLLECTOR EFFICIENCY
vs. INPUT POWER



製品取扱上のご注意

本製品は、内部にベリリア磁器（酸化ベリリウム）を使用しております。酸化ベリリウムは、その粉末や蒸気が人体の呼吸器系に入ると呼吸困難などの障害が起これ、危険ですので、製品の分解または化学的処理はされないようお願いいたします。

また、製品を廃棄する場合は、一般産業廃棄物あるいは家庭用ゴミとは必ず別にしてください。